

2SC3377

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコントランジスタ
 中電力増幅用/Medium Power Amp. T-27-13
 Epitaxial Planar NPN Silicon Transistor

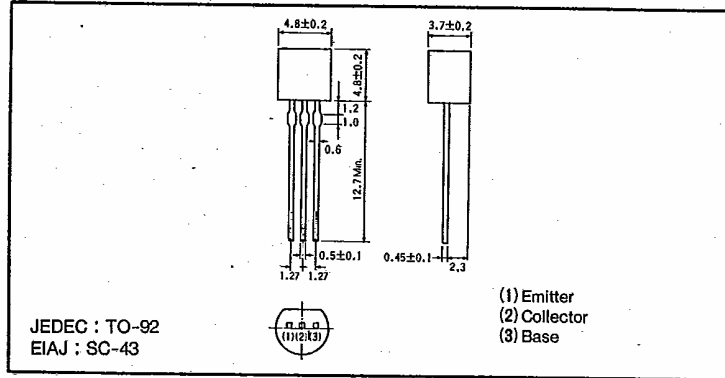
● 特長

1) $V_{CE(sat)}=150\text{mV}$ Typ. (at 500mA) と低い。

● Feature

1) Low collector saturation voltage:
 $V_{CE(sat)}=150\text{mV}$ (at 500mA)

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



トランジスタ
2SCタイプ

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	32	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	1	A
コレクタ損失	P_C	500	mW
接合部温度	T_J	125	$^\circ\text{C}$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~125	$^\circ\text{C}$

● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	32	—	—	V	$I_C=1\text{mA}$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	40	—	—	V	$I_C=50\mu\text{A}$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	5	—	—	V	$I_E=50\mu\text{A}$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	—	—	0.5	μA	$V_{CB}=20\text{V}$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	—	—	0.5	μA	$V_{EB}=4\text{V}$
直流電流増幅率	h_{FE}	82	—	390	—	$V_{CE}/I_C=3\text{V}/100\text{mA}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	0.4	V	$I_C/I_E=500\text{mA}/50\text{mA}$
利得帯域幅積	f_T	50	150	—	MHz	$V_{CE}=5\text{V}, I_E=-50\text{mA}$
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	15	30	pF	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0\text{A}, f=1\text{MHz}$

h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	P	Q	R
h_{FE}	82~180	120~270	180~390

● 標準品・準標準品一覧表

(◎: 標準品 ○: 準標準品)

Type	包装名	バルク	テーピング		
			記号	T91	T92
2SC3377	P	◎	○	○	○
	QR	◎	○	○	◎

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

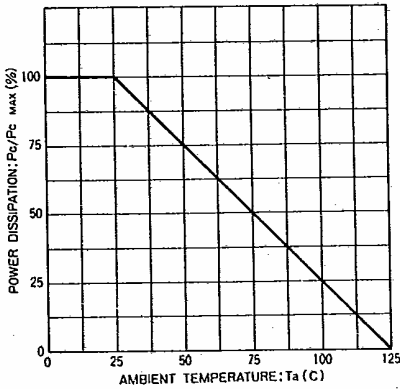


Fig.1 電力軽減曲線

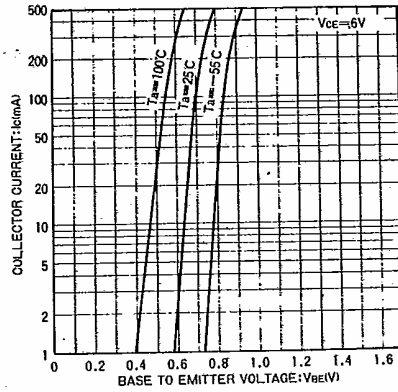


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

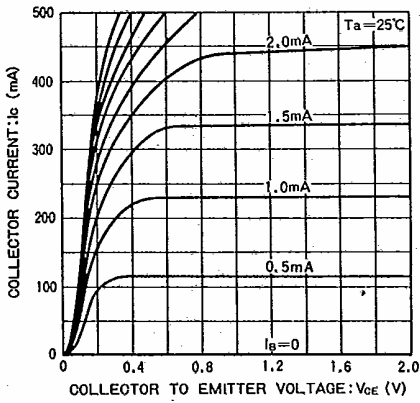


Fig.3 エミッタ接地出力静特性

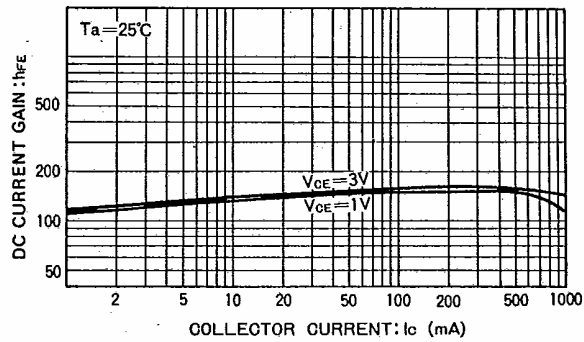


Fig.4 直流電流増幅率-コレクタ電流特性

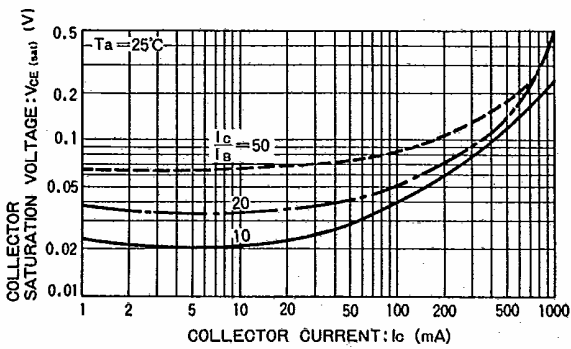


Fig.5 コレクタ・エミッタ飽和電圧-コレクタ電流特性

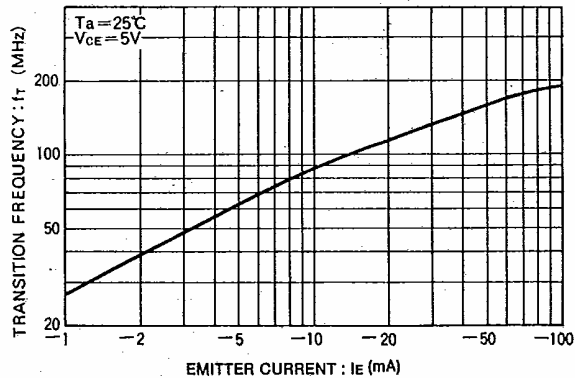


Fig.6 利得帯域幅積-エミッタ電流特性

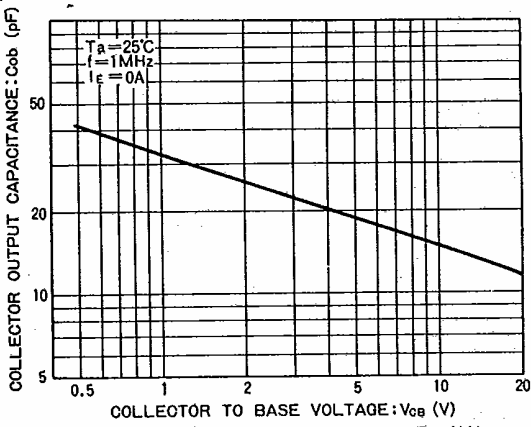


Fig.7 コレクタ出力容量—コレクタ・ベース電圧特性

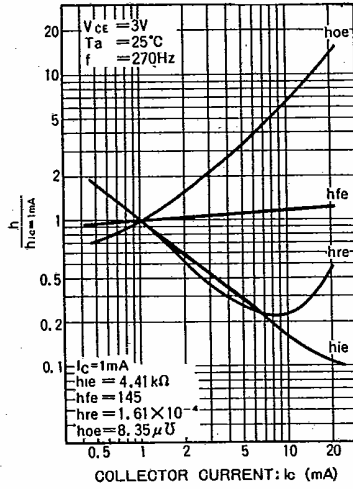


Fig.8 h定数—コレクタ電流特性

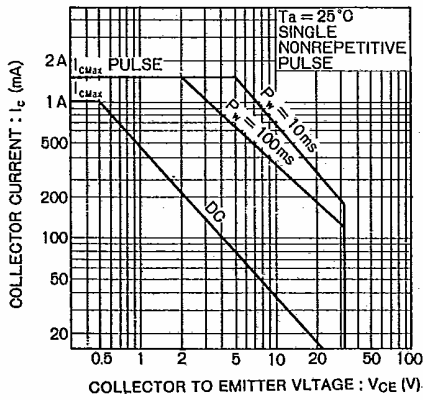


Fig.9 安全動作領域

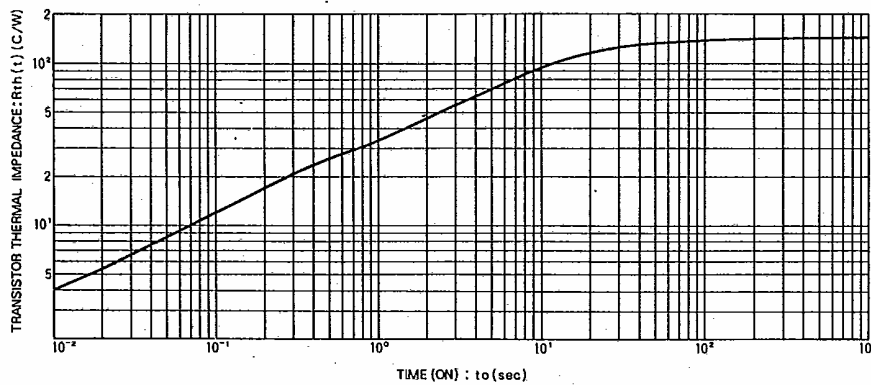


Fig.10 過渡熱抵抗

トランジスタ

2SCタイプ